











	<p>1N6483HE3/97</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 1N6483HE3/97</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p>
	<p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB</p>
	<p>Datenblätter:  1.1N6483HE3/97.pdf  2.1N6483HE3/97.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	1N6483HE3/97
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	DO-213AB
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	SUPERECTIFIER®
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-213AB, MELF (Glass)
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	8pF @ 4V, 1MHz

1N6483HE3/97 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N6483HE3/97-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N6483HE3/97 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 1N6483HE3/97 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>1N6483HE3/96 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB</p>	 <p>1N6483-E3/97 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB</p>	 <p>1N6484-E3/96 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 1A DO213AB</p>	 <p>1N6483-E3/97 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB</p>
 <p>1N6483-E3/96 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB</p>	 <p>1N6483HE3/97 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB</p>	 <p>1N6483HE3/96 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB</p>	 <p>1N6484-E3/97 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 1A DO213AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N6483HE3/97 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	1N6483HE3/97 Datenblatt	1N6483HE3/97-Datenblätter	1N6483HE3/97 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division 1N6483HE3/97
1N6483HE3/97 Electronic	1N6483HE3/97-Komponenten	1N6483HE3/97-Verteiler	1N6483HE3/97-Bild	1N6483HE3/97-Teil
1N6483HE3/97 Preis	1N6483HE3/97 Hersteller	1N6483HE3/97 Bild	1N6483HE3/97 Aktie	1N6483HE3/97 Inventar
1N6483HE3/97 Neu	1N6483HE3/97 Original	1N6483HE3/97 garantiert	1N6483HE3/97 RFQ	1N6483HE3/97 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited